

КП778
мощный вертикальный
n-канальный МОП-транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором, обогащением n-канала и встроенным обратносмещенным диодом. Предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах и преобразователях с непрерывным импульсным управлением, схемах управления электродвигателями и других блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры.

Зарубежные прототипы

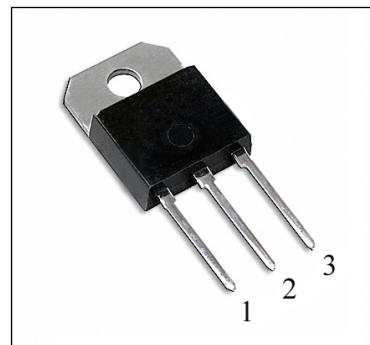
- Прототип – IRFP250

Обозначение технических условий

- АДБК 432140.811 ТУ

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-43 (ТО-218)



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Затвор
№2	Сток
№3	Исток

Таблица 1. Основные электрические параметры КП778

Параметры	Обозначение	Ед.изм.	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Ic=250мкА, Uзи=Uси	2.0	4.0
Ток стока КП778А КП778Б КП778В	Ic	А	ti ≤300мкс. Q ≥50 Uси=3.0В, Uзи=10В	30 25 23	- - -
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП778А КП778Б КП778В	Rси отк	Ом	ti ≤300мкс. Q ≥50 Ic=18А, Uзи=10В Ic=16А Ic=13А	- - -	0.085 0,12 0,14
Остаточный ток стока КП778А,Б КП778В	Ic ост	мкА	Uси=200, Uзи=0 Uси=250, Uзи=0		250 250
Ток утечки затвора	Iз ут	нА	Uси=0, Uзи=±20В	-	+100
Крутизна ВАХ КП778А КП778Б КП778В	S	А/В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Ic=18А Uси=50В, Ic=16А Ic=13А	12 8 11	- - -
Прямое напряжение диода КП778А КП778Б КП778В	Uпр	В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Ic=-30А, Uзи=0 Ic=-25А Ic=-23А		2.0 1,8 1,8
Время включения/выключения КП778А КП778Б КП778В	* твкл/ твыкл	нс	Uси=100В, Ic=30А, Rc=3.2Ом, Rг=6.2 Ом Uси=100В, Ic=17А, Rc=5,8Ом, Rг=4,7 Ом Uси=100В, Ic=23А, Rc=5,4Ом, Rг=6.2 Ом		140/190 160/250 120/180
Тепловое сопротивление переход-корпус	* Rt п-к	°С/Вт			0.65
Входная емкость	* C11и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		4000
Выходная емкость	* C22и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		1100
Проходная емкость	* C12и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		350
Время обратного восстановления диода КП778А КП778Б КП778В	tвос	нс	Iпр=30А, dI/dt=100 А/мкс ti ≤300мкс. Q ≥50 Iпр=30А, dI/dt=100 А/мкс ti ≤300мкс. Q ≥50 Iпр=30А, dI/dt=100 А/мкс ti ≤300мкс. Q ≥50		540 630 560

* Справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КП778

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения		
			А	Б	В
Напряжение сток-исток	Uси max	В	200	200	250
Напряжениезатвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20
Постоянный ток стока	Iс max	А	30	25	23
Импульсный ток стока	Iс и max	А	120	100	92
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	190	190	190
Прямой ток диода	Iпр. max	А	30	25	23
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>